Generative Adversarial Networks for Crystal Structure Prediction

本文使用GAN生成了Mg-Mn-O三元材料的结构,而后使用高通量虚拟筛选(HTVS)对这些材料的光阳级性进行了评价,找出了14种新成分。

数据集及处理

数据来源

从Material Project中构建Mg-Mn-O体系的数据库,去除重复后,保留了112种独特的成分和1240个独特的结构。而后,对每种组合使用数据增强技术,直到这些组合的每种结构达到1000种。由此,可以产生112000个Mg-Mn-O结构。

特征构建

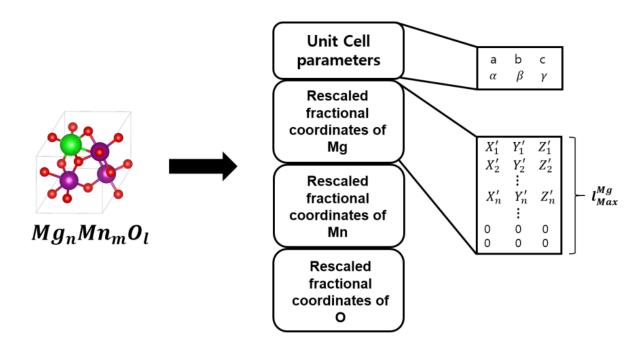
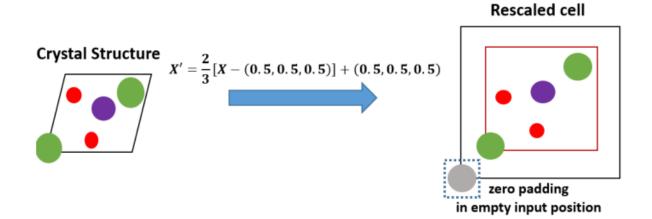


Figure S1. Specific representation of Mg-Mn-O structure.

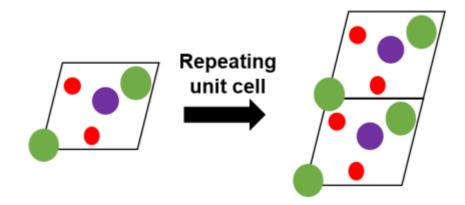
上图中的 $a \times b \times c \times \alpha \times \beta \times \gamma$ 是晶胞常数,右下的矩阵是经过缩放和归一化的矩阵。

- l_{Max}^{Mg} 表示表示Mg坐标的最大行数,取在化学式中可能达到的最大元素个数,在表示时空出的行会被0填充。在Mg-Mn-O体系中, l_{Max}^{Mg} 是8, l_{Max}^{Mn} 是8, l_{Max}^{O} 是12
- 为区分位于(0,0,0)的真实原子与用于固定形状的零填充,使用如下方法重新缩放了分数坐标:
 - 。 对于任意一点P(X,Y,Z), 会被缩放为: $P' = \frac{2}{3}[P (0.5,0.5,0.5)] + (0.5,0.5,0.5)$

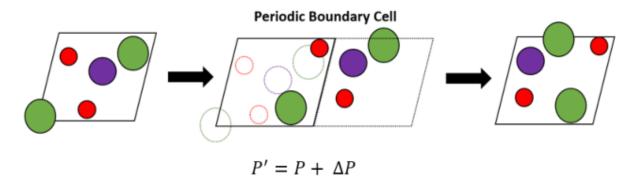


数据增强

• 超晶胞操作——在x-y轴、y-z轴和x-z轴上分别重复两次单位晶胞来制作超晶胞,其中的原子数不超过我们表示的最大原子数

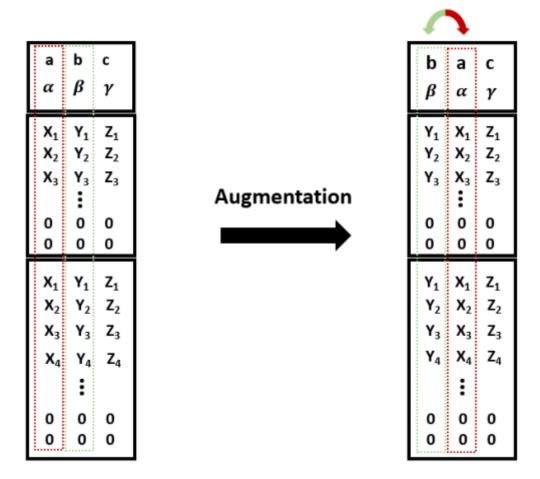


• 平移操作——对结构数据进行平移运算,将单位胞内原子按小于胞长的随机距离移动



$$\Delta P = \lambda * (l_{x}, l_{y}, l_{z})$$
 , (0< $\lambda <$ 1, $l = cell \ length)$

• 旋转操作——交换两个轴(列)对结构数据进行旋转操作



模型及细节

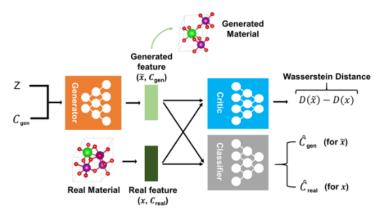


Figure 2. Composition-Conditioned Crystal GAN proposed in this work for inorganic crystal design. Z, $C_{\rm gen}$, and $C_{\rm real}$ denote a random input noise, user-desired composition condition, and composition of real material, respectively. The variables \tilde{x} and x denote the feature (representation) of generated and real materials, respectively. $\hat{C}_{\rm gen}$ and $\hat{C}_{\rm real}$ denote the predicted composition of the generated and real features, respectively. D(x) is the critic function also known as the critic network.

上述的GAN模型包含三个组件:生成器、评论器和分类器。生成器以随机高斯噪声向量(Z)和one-hot编码合成向量(C_{gen})作为输入,生成新的2d表示。评价器通过计算Wasserstein距离来进行优化。

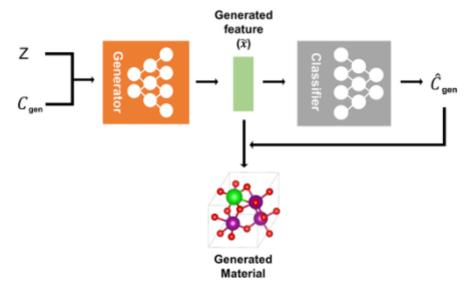
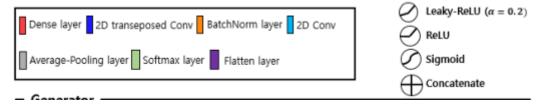


Figure 3. Schematic of the generation process for crystals with the desired composition. The composition of generated material is determined by the output of the classifier network.

在生成新材料时使用上面的结构进行生成。

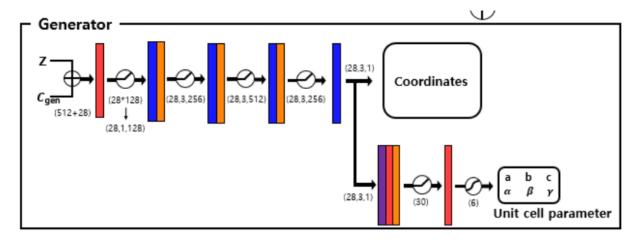
模型架构

• 符号定义

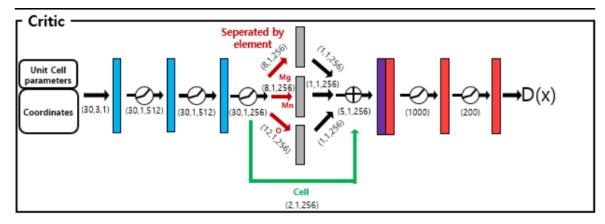


• 生成器

使用ReLU作为激活函数,一个全连接层+三个转置卷积和BatchNorm层+一个转置卷积层从而生成坐标,再在上面使用展平层+全连接层+BatchNorm层+全连接层+sigmoid生成晶胞常数



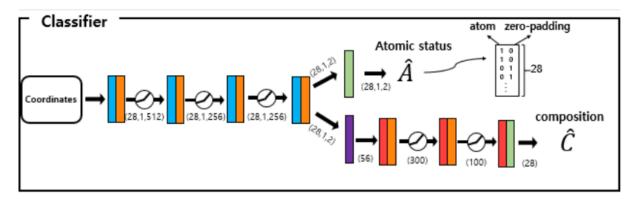
评价器



• 分类器

使用Leaky-ReLU作为激活函数,4个卷积BatchNorm层

- 。 加上一个Softmax层生成判定结果
- 。 加上展平层+2个全连接BatchNorm层+全连接Softmax层生成成分



超参数

Table S1. Hyperparameters of Composition-Conditioned Crystal GAN

Hyperparameter		Value
Mini batch size		32
Adam optimizer	Learning rate	0.0001
	eta_1	0.5
	eta_2	0.999
Coefficient of Gradient penalty, λ		10
Coefficient of generated data in $L_{class-comp}$, λ_1		1
Coefficient of generated data in $L_{class-atom}$, λ_2		1
Coefficient of Composition Classification, λ_c		0.3

损失函数

本文使用WGAN中所提出的损失函数,它解决了原始GAN中的训练的不稳定和模式崩溃等问题。其定义如下:

$$L_{WGAN} = \underset{\tilde{x} \sim \mathbb{P}_q}{\mathbb{E}} [D(\tilde{x})] - \underset{x \sim \mathbb{P}_r}{\mathbb{E}} [D(x)] + \lambda \underset{\hat{x} \sim \mathbb{P}_{\hat{x}}}{\mathbb{E}} [(\parallel \nabla_{\hat{x}} D(\hat{x}) \parallel_2 - 1)^2]$$

D是惩罚函数, $P_{\hat{x}}$ 是真实数据分布中采样的点对之间的直线均匀抽样, P_r 和 P_g 分别是真实分布和生成器的分布, λ 是惩罚系数,设为10。为了训练生成器创建具有目标属性的材料,生成器与带有损失函数的分类器一起训练:

$$L_{class-comp} = CE(C_{real}, \hat{C}_{real}) + \lambda_1 CE(C_{gen}, \hat{C}_{gen})$$

$$L_{class-atom} = CE(A_{real}, \hat{A}_{real}) + \lambda_2 CE(A_{gen}, \hat{A}_{gen})$$

$$L_{class} = L_{class-atom} + \lambda_c L_{class-comp}$$

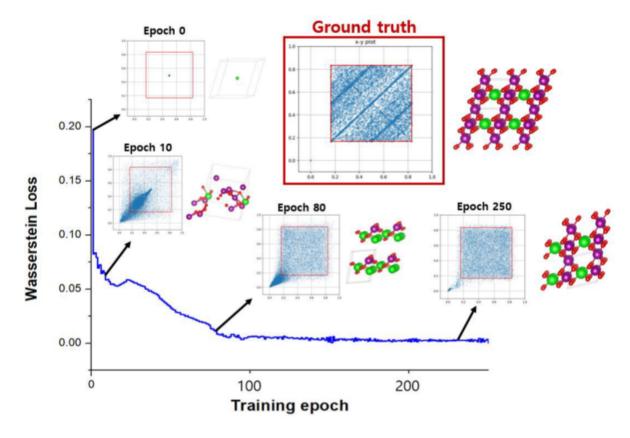
$$CE(t, x) = -\sum_{i}^{C} t_{i} \log(x_{i})$$

其中,CE是交叉熵损失, x_i 是分类器函数输出的第i个值,C是类别数量, t_i 是第i个目标值

C_{real}	\hat{C}_{real}	C_{gen}	$\hat{C_{gen}}$
真实材料的真实值	真实材料的预测值	生成材料的真实值	生成材料的预测值

 λ_1, λ_2 和 λ_3 分别是成分生成器、原子状态和成分系数中的参数

学习曲线



对于一种材料,通过分析它的晶体结构文件从而生成关于晶胞常数(长度和角度)和原子坐标(缩放后)的相关信息,如上图所示。

本文使用生成对抗模型生成了Mg-Mn-O三元材料,并使用高通量虚拟筛选(HTVS)对这些材料的光阳极性进行了评价。提出的HTVS框架预测了23种具有合理计算稳定性和带隙的新晶体结构。

HTVS常被用来从数据库中筛选具有前途的材料,目前的搜索是通过对晶体结构中的元素进行组合替换,然后筛选。但这种方法不能超越数据库中现有晶体结构的模板。

生成模型则侧重于构建一个连续的材料向量空间,在化学领域,常使用变分自编码器(VAE)和生成对抗模型(GAN)。

最早提出的编码晶体结构的表示方法之一是3d图像表示,但这种方法需要占据大量空间且训练时间慢。

结果和讨论

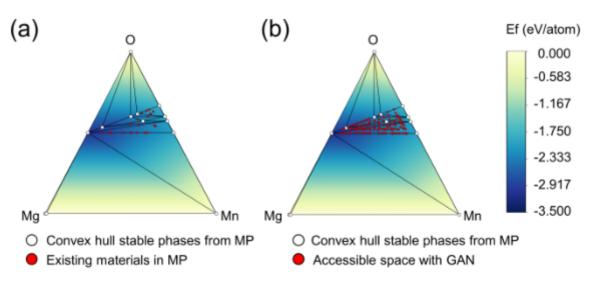
与iMatGen的对比

作者使用V-O体系分别在本文所提出的架构和iMatGen上进行了结构生成,然后对比了两者的效果:

- iMatGen发现的V-O亚稳态多态($E_{hull} \leq 200 \quad meV/atom$)中40%被当前GAN模型重新发现,剩余60%的差异可以解释为每个生成模型中潜在空间结构或采样方法的差异
- $\epsilon V_3 O_4 \pi V_6 O_7 + \epsilon$, 本文的GAN模型生成的结构更加稳定

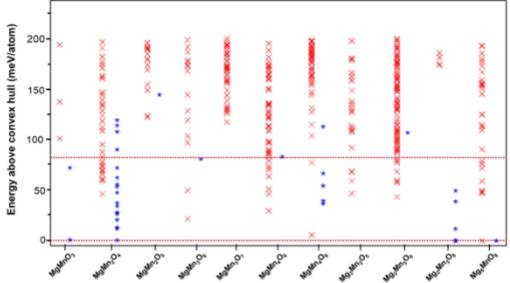
三元Mg-Mn-O光阳极材料的生成式高通量筛选

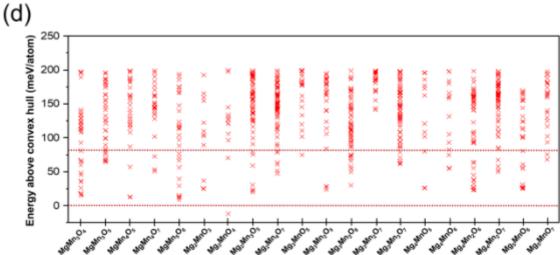
• 设定Mn氧化态条件 $(2 \le OS_{Mn} \le 4)$,从已有材料的化学空间(下图(a))展开,由此得到133种满足条件的候选成分(下图(b))



• 考虑到单位细胞中的原子数以及DFT计算成本,从113种材料中选择了31种化合物(11种在MP中(下图(c)),20种不在MP中(下图(d)))







- 使用图3过程进行采样,从11种在MP中的材料生成了3300种结构(上图(c))(包括在MP中已有的300种结构),从20种不在MP中的材料生成了6000种结构(上图(d))(不包括在MP中已有的300种结构)
- 性能评估

 - 。 上图 (d) 中,753种结构被预测为理论上亚稳的($E_{hull} \leq 200 \mod V/atom$,红色叉),其中113种结构被认为是潜在可合成的($E_{hull} \leq 80 \mod V/atom$)。对于 Mg_2MnO_4 这种不在MP中的成分,发现了一个对应于凸包最小值的结构。
- 光阳极材料——从 $E_{hull} \leq 80~meV/atom$ (c中的35种材料和d中的113种材料)的材料中测定 Pourbaix稳定性(ΔG_{pbx})和带隙(E_q^{HSE})进行筛选
 - o Pourbaix hull表示在给定PH和电化学条件下的水电环境中的稳定性(即基态和自由能的差值)

- 。 使用Pymatgen包进行计算,设定PH为0-14,1.5V vsRHE时Pourbaix hull Gibbls的最小自由能 ΔG_{pbx}^{min} ,对 $\Delta G_{pbx}^{min}(E_{form}) \leq 0.8$ eV/atom,继续进行HSE计算以计算带隙
- 。 通过设定 $\Delta G_{pbx}^{min}(E_{form}) \leq 0.59$ eV/atom,以及1.6 $eV \leq E_g^{HSE} \leq 3.0eV$,选出了 28种潜在的阳性材料,其中14种材料是在数据库中未包含的新成分

